

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第1区分
 【発行日】平成25年5月2日(2013.5.2)

【公開番号】特開2011-219319(P2011-219319A)
 【公開日】平成23年11月4日(2011.11.4)
 【年通号数】公開・登録公報2011-044
 【出願番号】特願2010-91352(P2010-91352)
 【国際特許分類】

C 3 0 B 29/06 (2006.01)

C 3 0 B 15/22 (2006.01)

C 3 0 B 33/00 (2006.01)

【F I】

C 3 0 B 29/06 5 0 2 J

C 3 0 B 15/22

C 3 0 B 33/00

【手続補正書】

【提出日】平成25年3月14日(2013.3.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

チョクラルスキー法により引き上げられた単結晶を所定長さ以下のブロックに切断し、得られたブロックの両端から採取したサンプルについて結晶欠陥を評価し、評価基準を満たすブロックを切り出して半導体ウェーハを製造する方法であって、

前記単結晶として、請求項2に記載の単結晶の製造方法により引き上げられ、かつ、引き上げる過程において引き上げ速度の実績値から算出される移動平均の揺らぎを管理したものを用い、

前記単結晶を所定長さ以下のブロックに切断する際に、単結晶を引き上げる過程で前記揺らぎが発生した位置で切断することを特徴とする半導体ウェーハの製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

(3) チョクラルスキー法により引き上げられた単結晶を所定長さ以下のブロックに切断し、得られたブロックの両端から採取したサンプルについて結晶欠陥を評価し、評価基準を満たすブロックを切り出して半導体ウェーハを製造する方法であって、前記単結晶として、上記(2)に記載の単結晶の製造方法により引き上げられ、かつ、引き上げる過程において引き上げ速度の実績値から算出される移動平均の揺らぎを管理したものを用い、前記単結晶を所定長さ以下のブロックに切断する際に、単結晶を引き上げる過程で前記揺らぎが発生した位置で切断することを特徴とする半導体ウェーハの製造方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0041

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0041】

本発明の半導体ウェーハの製造方法は、チョクラルスキー法により引き上げられた単結晶を所定長さ以下のブロックに切断し、得られたブロックの両端から採取したサンプルについて結晶欠陥を評価し、評価基準を満たすブロックをスライスして半導体ウェーハを製造する方法であって、単結晶として、前記(2)の本発明の単結晶の製造方法により引き上げられ、かつ、引き上げる過程において引き上げ速度の実績値から算出される移動平均の揺らぎを管理したものを用い、単結晶を所定長さ以下のブロックに切断する際に、単結晶を引き上げる過程で揺らぎが発生した位置で切断することを特徴とする。